

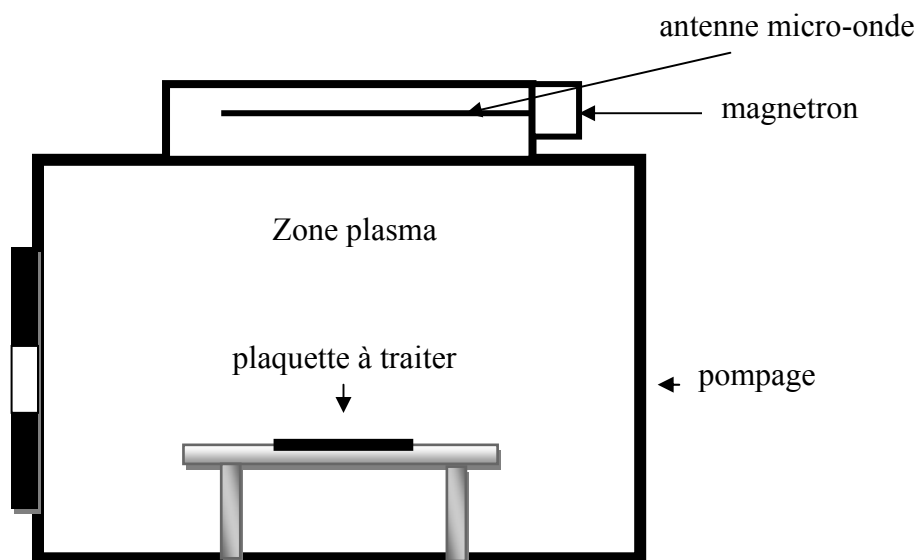
PLASMA DE DELAQUAGE ET DE TRAITEMENT DE SURFACE (TEPLA 300)

Cet équipement permet de réaliser par plasma continu, le délaquage de résines photosensibles. De plus il est utilisé pour « traiter ou fonctionnaliser » la surface des matériaux.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Source microonde 2.45GHz 1000W
- Température procédé 20°C à 150°C
- gaz : SF₆, CF₄, O₂.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT



Un gaz est introduit dans la chambre de gravure sous vide. Il est ionisé en un plasma réactif par l'intermédiaire d'un générateur radiofréquence qui excite un magnétron. Le plasma produit alors une attaque physico-chimique du matériau. Il en résulte des produits de réactions volatiles qui sont évacués par le système de pompage. L'équipement est équipé d'un système de détection de fin d'attaque.

CONTACTS

Pascal Dubreuil : dubreuil@laas.fr

Djaffar Belharet : dbelhare@laas.fr

Laurent Jalabert : jalabert@iis.u-tokyo.ac.jp

ENGLISH VERSION→

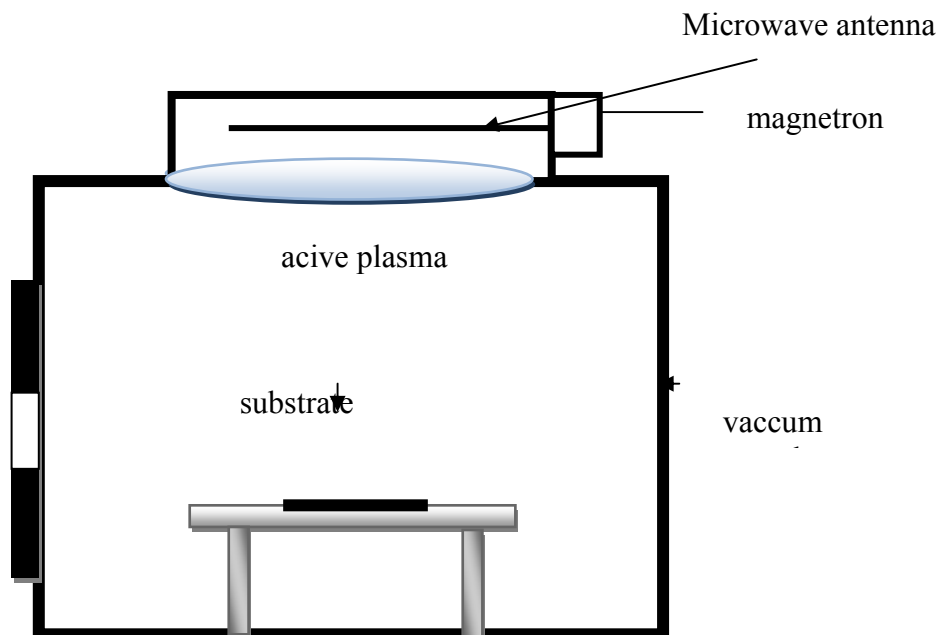
STRIPPING AND SURFACE ACTIVATION PLASMA (TEPLA 300)

This equipment enables continuous plasma etching for stripping of photoresists. In addition it is used to chemically activate the materials surface.

MAIN CHARACTERISTICS

- Micro-wave Source : 2.45GHz 1000W
- Process température 20°C à 150°C
- gas : SF6, CF4, O2.

PRINCIPLE



A gas is introduced into the vacuum chamber. The gas is ionized in reactive plasma with the help of a radio frequency generator that excite a magnetron. Plasma then produces a physico-chemical attack of the material. As a result, volatile reactions products are extracted by pumping system. The equipment is equipped with an end point detection system

CONTACTS

Pascal Dubreuil : dubreuil@laas.fr
 Djaffar Belharet : dbelhare@laas.fr
 Laurent Jalabert : jalabert@iis.u-tokyo.ac.jp

VERSION FRANCAISE→